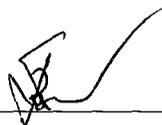


Ученая степень (№ диплома)	Доктор технических наук ДДН № 025644
Шифр и название научной специальности, по которой защищена диссертация	05.27.01– "Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах"
Ученое звание (по кафедре или специальности; № аттестата)	доцент ДЦ № 016428
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
Занимаемая должность (с указанием структурного подразделения)	профессор кафедры "Интегральная Электроника и Микросистемы"
Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15)	<p>1) Тимошенко В.П. Ефимов А.Г. Применение кремний-германиевой технологии в СВЧ модулях АФАР // Известия ВУЗов Электроника т.21 №3 2016 С.261-269.</p> <p>2) Тимошенко В.П. Ваньков В.А., Стародубцев К.С. Генератор управляемый напряжением для беспроводных мультистантартных применений // НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 10, 2015 С.55-64.</p> <p>3) Тимошенко В.П. Адамов Ю.Ф. Эквализация цифровых сигналов в СВЧ линиях связи // Электросвязь, №2,2014 С.41-43.</p> <p>4) V.Timoshenkov Y. Adamov. Self-heating compensation of SiGe HBT // Известия ВУЗов Электроника т.20 №3 2015 С.323-326.</p> <p>5) V.Timoshenkov Y. Chaplgin, Y. Adamov VBIC model application features at design of ASIC on SiGe HBT // VI All-Russia Science&Technology conference PROBLEMS OF ADVANCE MICRO - & NANOELECTRONIC SYSTEMS DEVELOPMENT - MES-2014 Part III "Design of analog and mixed VLSI IP blocs""Design of radiation - resistant VLSI circuits" ISBN 978-5-903559-48-0, pp.25-26.</p> <p>6) V.P. Timoshenkov R. K. Yafarov, E. S. Gornev, S. N. Orlov, S. P. Timoshenkov A. S. Timoshenkov // Formation of Field-Emission Emitters by Microwave Plasma-Chemical Synthesis of Nanocarbon Structures // SEMICONDUCTORS Vol. 50 No. 13 2016 P.1726-1728.</p> <p>7) В.П. Тимошенко А.И. Хлыбов Д.В. Родионов Исследование параметров НЕМТ транзистора в</p>

	гигагерцовом диапазоне // Нано и микросистемная техника том 19, №10, 2017, С.632-640 8) V.Timoshenkov Р.Яфаров Effect of the Distribution of the Radiation Defect on the Field-Emission Properties of Silicon Crystals // Russian Microelectronics, 2018, Vol. 47, No. 4, pp. 251–258
Являетесь ли Вы работником (в том числе по совместительству) организаций, где работает соискатель ученой степени, его научный руководитель?	Нет
Являетесь ли Вы работником (в том числе по совместительству) организаций, ведущих работы по контрактам, в которых занят соискатель ученой степени или его научный руководитель в качестве руководителя, исполнителя (соисполнителя)?	Нет
Являетесь ли Вы членом экспертного совета ВАК?	Нет


 /В.П. Тимошенко/
 м.п.

Подпись Тимошенко В.П. заверяю

